

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年7月5日(2007.7.5)

【公開番号】特開2006-100628(P2006-100628A)

【公開日】平成18年4月13日(2006.4.13)

【年通号数】公開・登録公報2006-015

【出願番号】特願2004-285752(P2004-285752)

【国際特許分類】

**H 01 L 21/3065 (2006.01)**

【F I】

H 01 L 21/302 105 A

【手続補正書】

【提出日】平成19年5月23日(2007.5.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

プラズマを生成し、試料に高周波電圧を印加することにより被処理材をエッチングする装置を用いて、Ar Fレジストマスクを用いてSiOCH膜のエッチングを行うエッチングプロセスにおいて、

CF<sub>4</sub>とCHF<sub>3</sub>の混合ガスまたはCHF<sub>3</sub>とN<sub>2</sub>の混合ガスもしくはCF<sub>4</sub>とN<sub>2</sub>の混合ガスを用い、

希ガス(例えばAr)を用いないことを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項2】

請求項1記載のプラズマ処理方法において、低圧力(2.0Pa以下)の圧力でプラズマ処理を行うことを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項3】

請求項1または請求項2記載のプラズマ処理方法において、

磁場を用いてプラズマを生成することを特徴とするプラズマ処理方法。